

2SD636, 2SD637

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

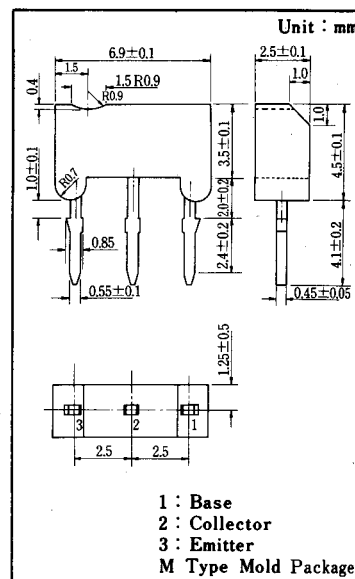
低電力一般増幅用

■ 特 長

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。
- M 型パッケージで自動挿入、手挿入が容易、P 板に自立固定できる。

■ 絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD636	30	V
	2SD637	60	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD636	25	V
	2SD637	50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	200	mA
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{ V}, I_E=0$			1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=20\text{ V}, I_B=0$			1	
コレクタ・ベース電圧	2SD636	$I_C=10\text{ }\mu\text{A}, I_E=0$	30			V
	2SD637		60			
コレクタ・エミッタ電圧	2SD636	$I_C=2\text{ mA}, I_B=0$	25			V
	2SD637		50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=10\text{ }\mu\text{A}, I_C=0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2\text{ mA}$	160		460	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{ mA}, I_B=10\text{ mA}$		0.3	0.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=-2\text{ mA}, f=200\text{ MHz}$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0, f=1\text{ MHz}$		3.5		pF

* h_{FE} ランク分類

ランク	Q	R	S
h_{FE}	160 ~ 260	210 ~ 340	290 ~ 460